

2200nm InGaAs/InP PIN PD Chip/TO



产品描述

InGaAs 传感用长波光探测器芯片及器件

产品特点

高响应度@2100nm；截止波长：2200nm；低暗电流；顶照式平面结构

应用领域

气体分析仪 | 湿度计 | 近红外传感

核心参数

无
无

详细参数

规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

有效面积尺寸: 250um/300um/500um/1000um

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	1000		2200	nm	
响应度	R		1.0		A/W	$\lambda=2100\text{nm}$
暗电流	I_D		150	500	nA	$V_R=-5V$
电容	C		150		pF	$V_R=-2V, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		0.5		GHz	$V_R=-2V$ 3dB down, RL=50 Ω
有效区直径	D		250-1000		um	